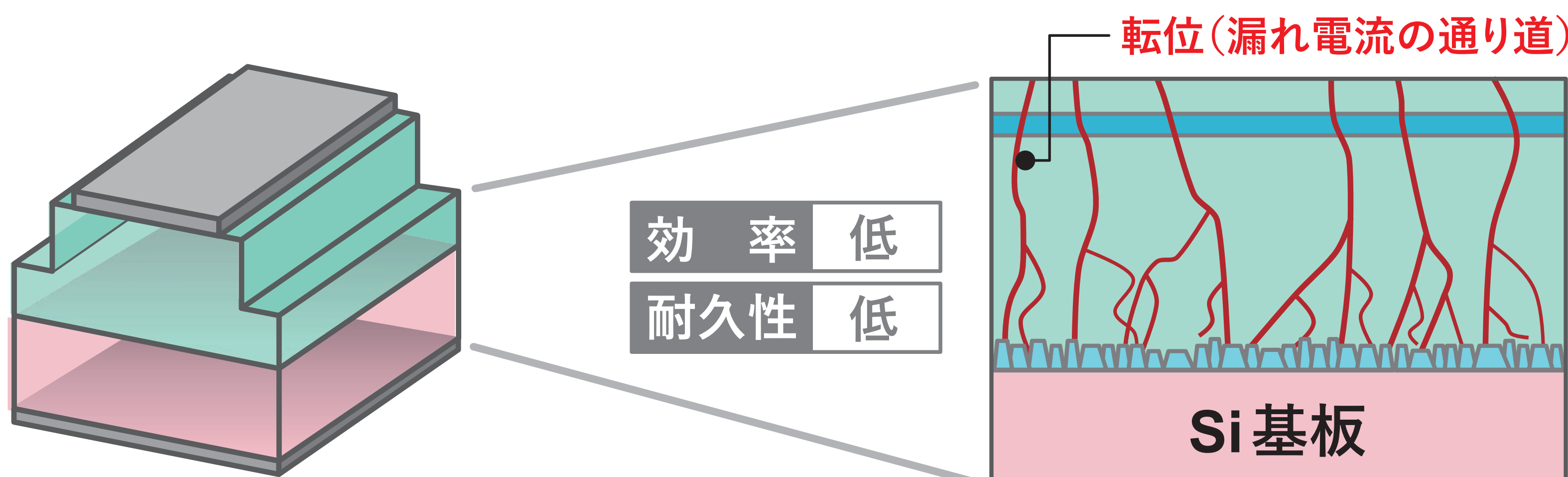


めざすGaNデバイス

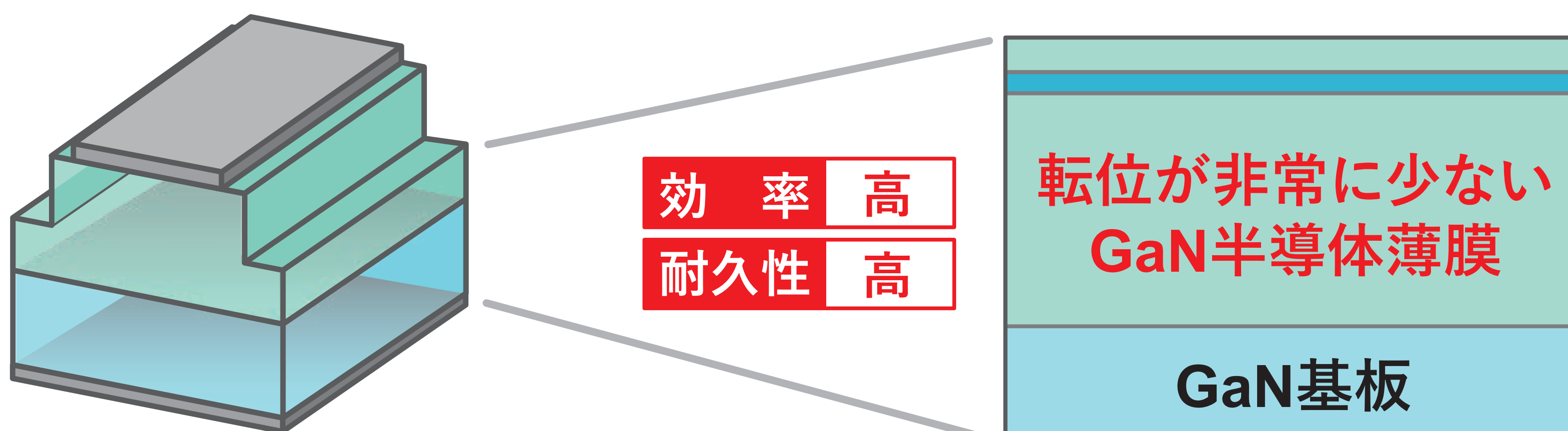
従来のGaNデバイス

- GaN-on-Si (Si基板上にGaN半導体薄膜を成膜)
- 安価だがGaNとSiの物性の違いにより結晶欠陥(転位)が多く、性能が発揮できていない



開発するGaNデバイス

- **GaN-on-GaN** (高品質GaN基板上にGaN半導体薄膜を成膜)
- 物性の一致により **高品質なGaN基板上に結晶欠陥(転位)の非常に少ない薄膜が形成でき、理論通りの性能を発揮**



GaNデバイスによるCO2削減効果

電力変換時にエネルギーを損失

